

# XII Российская конференция по физике полупроводников

Звенигород, 21-25 сентября 2015



Итоги конференции

Главная

Комитеты

Тематика

Приглашенные доклады

Организаторы и спонсоры

Принятые доклады

Оргвзнос

Программа

Устные доклады

**Стендовые доклады**

Экскурсия

Культурная программа

Как добраться

Контакты

Фотографии

Вход	
Логин:	<input type="text"/>
Пароль:	<input type="password"/>
<input type="button" value="Войти"/>	
<a href="#">[ Забыли? ]</a>	

## Контакты:

### Программный комитет

**Акимченко**

**Ирена Петровна**

тел.: 8-499-131- 47-52

[iakimchenko@mail.ru](mailto:iakimchenko@mail.ru)

### Организационный комитет

**Пручкина**

**Анна Артемовна**

тел.: 8-499-132-64-48

факс: 8-499-135-23-20

[semicond-](mailto:semicond-2015@sci.lebedev.ru)

[2015@sci.lebedev.ru](mailto:2015@sci.lebedev.ru)

**Алещенко**

**Юрий Анатольевич**

тел.: 8-499-132-63-61,

8-499-132-62-93

факс: 8-499-135-23-20

[\[2015@sci.lebedev.ru\]\(mailto:2015@sci.lebedev.ru\)](mailto:semicond-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

## Важные даты:

**2 февраля 2015 г.**

Первое извещение

**3 февраля 2015 г.**

Начало регистрации

**30 марта 2015 г.**

Окончание подачи тезисов

**15 мая 2015 г.**

Информация о принятии

доклада

**22 мая 2015 г.**

Второе извещение

**21 сентября 2015 г.**

Начало конференции.

## Научная программа - стендовые сессии

Три двухчасовые стендовые сессии будут проведены вечером перед ужином

**в понедельник 21 сентября** (тематические разделы [2, 3, 14](#)),

**во вторник 22 сентября** (тематические разделы [1, 4, 5, 8, 10](#)) и

**в среду 23 сентября** (тематические разделы [6, 7, 9, 11, 12, 13](#)) в фойе Культурно-спортивного центра. Формат кода стендового сообщения: <День недели> <Тематика> <Номер стенда> <с — стенд>.

### Стендовая сессия I (тематические разделы [2, 3, 14](#)) Понедельник 18:00–20:00

#### 2. Поверхность, пленки, слои

**Пн 2-1с М. В. Дорохин, Д. А. Павлов, А. И. Бобров, Ю. А. Данилов, П. Б. Дёмина, Б. Н. Звонков, А. В. Здоровейцев, А. В. Кудрин, Н. В. Малехонова, Е. И. Малышева**

Эпитаксия ферромагнитных квазикристаллов Mn<sub>x</sub>Ga<sub>y</sub> на поверхности GaAs

**Пн 2-2с Ю. Г. Шретер, В. В. Вороненков, В. С. Коготков,**

**М. В. Вирко, Р. И. Горбунов, Ф. Е. Латышев, Н. И. Бочкарёва, А. А. Леонидов, А. С. Зубрилов, Ю. С. Леликов, Ю. Т. Ребане**

Физические основы отделения тонких слоёв от объёмных подложек сверхкороткими лазерными импульсами

**Пн 2-3с А. В. Новиков**

Формирование и селективное легирование SiGe низкоразмерных структур и их использование для приборных приложений

**Пн 2-4с Е. В. Тихонов, С. В. Лепешкин, Н. Л. Мацко, В. С. Батулин, Ю. А. Успенский, Д. Р. Хохлов**

Первопринципное исследование структуры кремниевых нанокластеров, пассивированных кислородом

**Пн 2-5с В. В. Румянцев, С. В. Морозов, А. В. Антонов, К. Е. Кудрявцев, S. Winnerl, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий, М. Helm, В. И. Гавриленко**

Времена жизни неравновесных носителей заряда в узкозонных эпитаксиальных слоях и структурах с квантовыми ямами на основе HgCdTe в условиях сильного возбуждения

**Пн 2-6с П. А. Дементьев, М. В. Лебедев, Т. В. Львова, И. В. Седова, А. А. Ситникова, В. А. Соловьев, С. В. Иванов**

Сульфидная пассивация поверхности (100) InSb для молекулярно-пучковой гомоэпитаксии

**Пн 2-7с М. С. Дунаевский, П. А. Алексеев, А. А. Донцов, А. М. Монахов, А. Varanov**

Метод измерения светочувствительного сдвига резонансной частоты АСМ-зонда для ближнепольной диагностики светоизлучения полупроводниковых лазеров

**Пн 2-8с А. В. Войцеховский, С. Н. Несмелов, С. М. Дзядух, В. В. Васильев, В. С. Варавин, С. А. Дворецкий, Н. Н. Михайлов, М. В. Якушев, Г. Ю. Сидоров**

Свойства границы раздела варизонного МЛЭ Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te с пассивирующими покрытиями SiO<sub>2</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**Пн 2-9с А. Г. Журавлев, А. С. Романов, В. Л. Альперович**

Влияние адсорбции кислорода на вероятность эмиссии электронов из Cs/GaAs(001) в вакуум

**Пн 2-10с М. С. Аксенов, А. Ю. Широков, В. А. Голяшов, С. Е. Хандархаева, А. К. Гутаковский, А. В. Бакулин, С. Е. Кулькова, Н. А. Валишева, О. Е. Терещенко**

Пассивация поверхности InAs фтором при сухом окислении в таунсендовском разряде

**Пн 2-11с М. В. Гомоюнова, Г. С. Гребенюк, И. И. Пронин**

Формирование ферромагнитных пленок силицида кобальта Co<sub>3</sub>Si на поверхности монокристаллического кремния

**Пн 2-12с Н. А. Тулина, А. Н. Россолонко, И. М. Шмытько, Н. Н. Колесников, Д. Н. Борисенко, В. В. Сироткин, И. Ю. Борисенко**

Получение и исследование мезоскопических гетероструктур на основе селенида висмута Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>

**Пн 2-13с Е. В. Гущина, О. А. Маслова, J. Alvarez, W. Favre, R. Varache, M. E. Gueunier-Farret, А. С. Гудовских, А. В. Анкудинов, Е. И. Теруков, J. P. Kleider**

Изучение границы a-Si:H/c-Si на сколах гетероструктур с помощью сканирующей зондовой микроскопии

**Пн 2-14с Т. В. Павлова, Г. М. Жидомиров, К. Н. Ельцов**

Динамика гетерогенной химической реакции хлорирования Cu(111)

**Пн 2-15с М. В. Лебедев**

Модификация поверхности полупроводников A<sub>3</sub>B<sub>5</sub> посредством зарядового обмена на границе с раствором

**Пн 2-16с С. Б. Бодров, А. А. Мурзанев, Ю. А. Мальков, Ю. А. Сергеев, А. Н. Степанов, Д. А. Яшунин**  
Исследование генерации второй гармоники оптического излучения с поверхности металла при воздействии мощного терагерцового поля

**Пн 2-17с В. Б. Шмагин, К. Е. Кудрявцев, Д. В. Шенгуров, З. Ф. Красильник**  
Поглощение Урбаха и флукутации зонного потенциала в эпитаксиальных слоях Si:Er

**Пн 2-18с Д. М. Казанцев, И. О. Ахундов, Н. Л. Шварц, В. Л. Альперович, А. С. Терехов, А. В. Латышев**

Выглаживание и разупорядочение ступенчато-террасированной поверхности GaAs: эксперимент и Монте-Карло моделирование

**Пн 2-19с Р. К. Яфаров, В. Я. Шаныгин**

Поверхностный фазовый переход в системе углерод – кремний

**Пн 2-20с Б. А. Андреев, П. А. Бушуйкин, Е. В. Демидов, Д. Н. Лобанов, А. В. Новиков, Е. В. Скороходов, П. А. Юнин**

Рост и оптоэлектронные свойства слоёв InN, выращенных методом МПЭ ПА при различных соотношениях потоков элементов III и V групп

**Пн 2-21с Б. А. Андреев, О. Б. Гусев, А. Н. Яблонский, А. В. Ершов, Д. А. Грачев, И. Н. Ясиевич, З. Ф. Красильник**

Спектры возбуждения и кинетика люминесценции экситонов, автолокализованных на состояниях поверхностных димеров в нанокристаллах кремния